

8524.91.00	004	Módulos de visualização de tela plana, baseados em tecnologia de cristais líquidos (LCD), podendo ou não incorporar camada sensível ao toque (touch screen), destinados à integração em caixas registradoras.	01/03/2026	28/06/2026
8524.91.00	005	Módulos de visualização de tela plana por tecnologia de cristal líquido (LCD), com diagonal de tela superior a 4,0 e inferior ou igual a 120,0 polegadas, podendo apresentar-se em estado de painel aberto (Open Cell) sem unidade de retroiluminação (backlight) ou com módulo de retroiluminação e moldura integrada, dotados ou não de painel sensível ao toque (touch screen), placas de circuito impresso flexíveis (FPC), circuitos integrados de acionamento (Source/Gate Drives) e conectores para interface de dados e alimentação.	01/03/2026	28/06/2026
8524.92.00	001	Módulos de visualização de tela plana, baseados em tecnologia de diodos emissores de luz orgânicos (OLED), podendo ou não incorporar camada sensível ao toque (touch screen), destinadas à integração em equipamentos eletrônicos.	01/03/2026	28/06/2026
8524.92.00	002	Módulos de visualização de tela plana por tecnologia de diodos emissores de luz orgânicos (OLED), com diagonal ou diâmetro de tela não superior a 120,00 polegadas, podendo apresentar-se em estado de painel aberto ou montada com circuitos de acionamento dos pontos de imagem, elemento de conexão, carcaça de proteção e suportes de fixação, dotados ou não de painel sensível ao toque (touch screen), destinados à integração em equipamentos eletroeletrônicos.	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.21	001	Dispositivos semicondutores, do tipo diodos "Zener", montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device).	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.21	002	Dispositivos semicondutores - Diodos Zener, montados, próprios para montagem em superfície (SMD), com tensão zener (Vz) compreendida entre 1,2 V a 200 V, e corrente direta de 100 nA a 588 mA, temperatura de operação na faixa de -65 a 150 graus Celsius, aplicados em placas de circuito impresso.	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.22	001	Diodos, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3A, montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device), exceto diodos Zener, fotodiodos e diodos emissores de luz (LED).	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.22	002	Diodos retificadores, próprios para montagem em superfície (SMD), com corrente direta média máxima compreendida entre 0,01 A e 3 A, tensão de pico inversa repetitiva máxima compreendida entre 1 V e 2.000 V, temperatura de operação na faixa de -65 a 260 graus Celsius, aplicados em placas de circuito impresso.	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.29	001	Diodos retificadores de silício, tipo semicondutor de junção, para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device), com intensidade de corrente nominal inferior ou igual a 3A, destinados à retificação, comutação e proteção contra transientes em placas de circuito impresso.	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.29	002	Diodos, de intensidade de corrente superior a 3A, montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device), exceto diodos Zener, fotodiodos e diodos emissores de luz (LED).	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.29	003	Diodos, semicondutores, montados, do tipo "Schottky" de potência, duplos (2 ânodos e cátodo comum), próprios para montagem em superfície (SMD), encapsulados em D2PAK ou TO-263, com tensão reversa máxima igual ou superior a 200V, corrente direta média retificada igual ou superior a 10A, destinados à retificação e comutação de potência em fontes de alimentação, conversores estáticos e equipamentos eletrônicos e de telecomunicações.	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.29	004	Diodos semicondutores montados, próprios para proteção contra surtos transitórios (TVS), do tipo "array" integrado, para montagem em superfície (SMD), encapsulados em SOT-363 ou SC-88, com tensão reversa máxima de trabalho de até 5V, capazes de proteger até 4 linhas de dados contra sobretensões transitórias, caracterizados por baixa capacitância por canal e capacidade de absorção de correntes de pulso transitórias, com corrente de pulso de pico maior ou igual a 8A, destinados à proteção ESD, EFT e surtos em linhas de dados de alta velocidade, tais como Ethernet, DSL, USB e interfaces digitais equivalentes, em equipamentos eletrônicos e de telecomunicações.	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.29	005	Diodos semicondutores montados, próprios para proteção contra surtos transitórios (TVS), do tipo bidirecional, discretos, para montagem em superfície (SMD), encapsulados em SOD-323, com tensão de trabalho nominal de 15V, capacidade de dissipação de potência de pulso (Peak Pulse Power) igual ou superior a 400W, capacitância típica maior ou igual a 40pF, destinados à proteção contra sobretensões e transientes em linhas de sinal, controle e alimentação de equipamentos eletrônicos e de telecomunicações.	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.29	006	Dispositivos semicondutores - Diodos retificadores, próprios para montagem em superfície (SMD), com corrente direta média máxima compreendida entre 3,1 e 710 A, tensão de pico inversa repetitiva máxima compreendida entre 3,3 e 700V, temperatura de operação na faixa de -65 a 260 graus Celsius, aplicados em placas de circuito impresso.	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.31	001	Diodos ZENER, montados, próprios para montagem por inserção (PTH - Pin Through Hole).	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.31	002	Dispositivos semicondutores - Diodos Zener, montados, próprios para montagem por inserção (PTH), com tensão zener (Vz) compreendida entre 4,7 V a 51 V, e corrente direta (Iz) de 5 mA a 200 mA, temperatura de operação na faixa de -65 a 150 graus Celsius, aplicados em placas de circuito impresso.	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.32	001	Dispositivos semicondutores, do tipo diodos retificadores de silício, montados, próprios para montagem por inserção (PTH - Pin Trough Hole), com intensidade de corrente nominal inferior ou igual a 3A, destinados à retificação, comutação e proteção contra transientes em placas de circuito impresso.	01/03/2026	28/06/2026
8541.10.32	002	Diodos Montados, próprios para montagem por inserção (PTH - Pin Through Hole) com intensidade de corrente inferior ou igual a 3A.	01/03/2026	28/06/2026
8541.21.20	001	Transistores, com capacidade de dissipação inferior a 1W, montados, próprios para montagem em superfície (SMD), podendo ser do tipo NPN ou PNP, simples (1 transistor) ou com múltiplos transistores no mesmo encapsulamento, e/ou até mesmo ter outros componentes encapsulados juntos, tais como diodos, resistores etc.	01/03/2026	28/06/2026
8541.21.20	002	Transistores com capacidade de dissipação inferior a 1W, montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device), exceto os fototransistores.	01/03/2026	28/06/2026
8541.21.20	003	Transistores, montados, com capacidade de dissipação inferior a 1 W, próprios para montagem em superfície (SMD), com corrente variando de 0,02 a 24A, tensão variando de 6 a 600V, operando em temperatura na faixa de -55 a 175 graus Celsius, aplicados em placas de circuito impresso.	01/03/2026	28/06/2026
8541.21.20	004	Transistores semicondutores montados, em encapsulamento SMD, com potência de dissipação igual ou inferior a 1W, destinados a aplicações de amplificação, chaveamento e controle eletrônico em placas de circuito impresso de equipamentos eletrônicos e sistemas de telecomunicações.	01/03/2026	28/06/2026
8541.29.20	001	Módulos semicondutores de potência, baseados em tecnologia de Transistor Bipolar de Porta Isolada (IGBT), montados em encapsulamento plástico ou cerâmico, próprios para comutação e controle de energia elétrica, com tensão máxima de coletor-emissor (Vces) compreendida entre 25 e 7.000V, corrente contínua de coletor (Ic) compreendida entre 1,5 e 2.400A, temperatura de operação na faixa de -55 a +175 graus Celsius, com terminais de conexão projetados para montagem em placa de circuito impresso (PCB) ou fixação em dissipadores.	01/03/2026	28/06/2026
8541.29.20	002	Transistores, de canal N ou P, controlados por tensão dreno-fonte (Vds) compreendida entre 6 e 3.600V, corrente de dreno de 0,1 a 300A, potência de dissipação de 0,2 a 1.000W, temperatura de -55 até 175 graus Celsius, próprios para montagem em superfície ou orifício passante em placas de circuito impresso, utilizados para controlar, chavear ou amplificar sinais eletrônicos em aplicações de alta potência.	01/03/2026	28/06/2026
8541.29.20	003	Transistores com capacidade de dissipação igual ou superior a 1W, montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) ou por inserção (PTH - Pin Through Hole), exceto os fototransistores.	01/03/2026	28/06/2026
8541.29.20	004	Dispositivos semicondutores - transistores, montados, com capacidade de dissipação igual ou superior a 1W, próprios para montagem em superfície (SMD) ou por inserção (PTH), com corrente variando de 0,01A a 301A, tensão variando de 6 V a 3.600V, operando em temperatura na faixa de -55°C a 175°C, aplicados em placas de circuito impresso.	01/03/2026	28/06/2026
8541.29.20	005	Transistores semicondutores montados, em encapsulamento SMD, destinados a aplicações de amplificação, chaveamento e controle eletrônico, utilizados em placas de circuito impresso de equipamentos eletrônicos e sistemas de telecomunicações.	01/03/2026	28/06/2026
8541.41.21	001	Diodos emissores de luz (LED), montados, próprios para montagem em superfície (SMD), com corrente direta média máxima variando de 2 a 150mA, tensão reversa máxima variando de 1,2 a 24V, operando em temperatura na faixa de -40 a 125 graus Celsius, aplicados em placas de circuito impresso.	01/03/2026	28/06/2026
8541.41.21	002	Diodos emissores de luz (LED), montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device), exceto diodos laser.	01/03/2026	28/06/2026
8541.42.20	001	Células fotovoltaicas solares não montadas em módulos nem em painéis, para utilização em controles remotos de televisores.	01/03/2026	28/06/2026
8542.32.21	001	Circuitos integrados eletrônicos, tipo memória semicondutora não volátil (o EEPROM), regravável, que retém dados mesmo sem energia elétrica, com capacidade de armazenamento de 128kBytes, com tempo de acesso inferior ou igual a 25ns, montados, próprios para montagem em superfície (SMD).	01/03/2026	28/06/2026
8542.32.21	002	Circuitos integrados eletrônicos, memórias, montadas, próprias para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device), dos tipos EEPROM.	01/03/2026	28/06/2026
8542.32.21	003	Circuitos integrados eletrônicos, memórias, montadas, próprias para montagem em superfície (SMD - surface mounted device), dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, flash, NAND.	01/03/2026	28/06/2026
8542.32.21	004	Circuitos integrados eletrônicos, memórias montadas ou próprias para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device), dos tipos EEPROM, com capacidade de armazenamento entre 1Kbit a 16Mbits, tensão de operação entre 0.5V a 6.5V, e temperatura de operação entre -65 a 150 graus Celsius.	01/03/2026	28/06/2026
8542.32.21	005	Circuitos integrados eletrônicos, memórias montadas ou próprias para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device), dos tipos FLASH com capacidade de armazenamento de 1MG e tempo de acesso não superior a 1ms.	01/03/2026	28/06/2026
8542.32.21	006	Memórias montadas, próprias para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM e FLASH; exceto DDR/PDDR.	01/03/2026	28/06/2026
8542.39.31	001	Circuitos integrados eletrônicos do tipo chipset, montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device).	01/03/2026	28/06/2026
8542.39.91	001	Placas de circuitos impressos e montados em pequenas dimensões com componentes eletrônicos (ativos e passivos) para uso em cartuchos de impressoras a laser.	01/03/2026	28/06/2026

ANEXO III

NCM	Descrição
8471.30.12	De peso inferior a 3,5 kg, com tela de área superior a 140 cm2, mas inferior a 560 cm2
8471.30.19	Outras
8473.30.11	Com fonte de alimentação, mesmo com módulo display numérico
8473.30.19	Outros
8473.30.41	Placas-mãe (mother boards)
8517.13.00	--Telefones inteligentes (smartphones)
8517.62.41	Com capacidade de conexão sem fio
8517.62.49	Outros
8528.52.00	--Capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina
8542.31.10	Não montados
8542.31.20	Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device)
8443.32.22	De caracteres braille
8471.60.53	Indicadores ou apontadores (mouse e track-ball, por exemplo)
8471.60.54	Mesas digitalizadoras

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

PORTARIA SRI/PR Nº 125, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026

Institui o Grupo Temporário de Acompanhamento das ações federais nas áreas afetadas em razão das fortes chuvas no Estado de Minas Gerais.

A MINISTRA DE ESTADO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I, II e IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Capítulo VI do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, resolve:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, o Grupo Temporário denominado "Grupo Temporário de Acompanhamento das ações federais nas áreas afetadas em razão das fortes chuvas no Estado de Minas Gerais", com a finalidade de acompanhar as ações nas áreas afetadas pelas chuvas intensas iniciadas em fevereiro de 2026.

- Art. 2º Compete ao Grupo Temporário:
- I - promover a articulação político-institucional entre o Governo Federal, o Governo do Estado de Minas Gerais e os Municípios afetados, facilitando a cooperação mútua;
 - II - promover o alinhamento das ações do Governo Federal no âmbito local;
 - III - atuar na mediação e solução de eventuais divergências institucionais ou impasses burocráticos que possam retardar a implementação das ações emergenciais; e
 - IV - elaborar relatórios periódicos aos Ministros de Estado dos órgãos que compõem este Grupo Temporário.
- Art. 3º O Grupo Temporário será composto por um representante de cada um dos seguintes órgãos:
- I - Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que o coordenará;
 - II - Casa Civil da Presidência da República;
 - III - Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional;
 - IV - Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania;
 - V - Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República; e

